

备注:

- 1、VBAT, BT_AVDD必须使用 耐压值为16V的原装电容。
- 2、VDDIO, VBAT必须使用原装电容, 以防漏电。
- 3、没有备注耐压值的电容, 统一用耐压值6.3V的电容, 所有电容 请使用原装电容, 以保证容值。

内置触摸设计要求:

- 1、布局, 布局允许的情况下, 触摸点离芯片引脚距离越近越好
- 2、走线, 保证最小线宽的前提下, 走线越细越好
- 3、走线, 远离DAC, IIC, SPI等信号线
- 4、铺铜, 保证PCB板地的完整性前提下, 触摸走线和GND安全间距越大越好
- 5、触点, 铜箔、PFC和外壳的接触面积越大, 贴合越紧密效果越好

The diagram shows a 24M crystal connected between the BT OSC1 and BT OSC2 pins. One terminal of the crystal is connected to BT OSC1, and the other terminal is connected to BT OSC2. The crystal is represented by a blue rectangle with two vertical lines inside, and the value '24M' is written above it.



D4和D5用来解决烧写升级时的ESD问题
若烧写升级环境已做好防护，可不贴

备注：
以上为推荐值
电容和电感的实际值大小以调试为准

备注:

- 1、AGND单独走线，走线尽量宽，在电池地 处短接
- 2、电池必须 带保护板，或带保护 电路

POWER